

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ



دانشکده فیزیک

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته فیزیک

گروه علوم پایه

بررسی تاثیر آلایش کروم روی خواص ساختاری و مغناطیسی
فریت منگنز ساخته شده به روش آسیاب گلوله ای

حمزه قربانی

استاد راهنما :

دکتر مهین اشرافی

استاد راهنمای همکار و مشاور :

دکتر علی اصغر شکری

۱۳۹۳ مهر

اینجانب حمزه قربانی دانشجوی ورودی سال ۱۳۸۸ مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد گواهی می نماید چنانچه در پایان نامه خود از فکر ، ایده و نوشه دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و مأخذ آن نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدینهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.

دانشجو تایید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه (رساله) نتیجه تحقیقات خودش می باشد . و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است.

حمزه قربانی

مهر ماه هزار و سیصد و نود و سه

اینجانب حمزه قربانی دانشجوی ورودی سال ۱۳۸۸ مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار کتاب و... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنمای با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله ، کتاب و... و به صورت مشترک و با نام استاد راهنمای مبادرت نمایم.

حمزه قربانی

مهر ماه هزار و سیصد و نود و سه

کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد.

مهر ماه هزار و سیصد و نود و سه

ثنا و حمد بی پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد مارا

و اما بعد ؟

بر خود وظیفه می دانم از خانواده ام (همسر و پدر و مادر) به خاطر حمایتها و همکاریها یشان تشکر کنم. همچنین از زحمات استاد راهنما دکتر مهین اشرافی و نیز دکتر پرویز کاملی و دکتر علی اصغر شکری بسیار سپاسگذارم. از همکاری و راهنماییهای خانم رحیمی کمال تشکر را دارم و در پایان از همه مسولین و همکاران محترم در دانشگاه پیام نور تهران ، دانشگاه پیام نور نجف آباد و دانشگاه صنعتی اصفهان به خاطر استفاده از امکانات آزمایشگاهی و همکاری هایشان متشرکرم.

تقدیم به :

عالیم پنهان از نظر

تقدیر از :

دو تاج سر، پدر و مادر

دو یار بَر، همسر و دختر

چکیده:

در این تحقیق به ساخت و مطالعه‌ی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منگنز آلایش داده شده با کروم به جای آهن به روش آسیاب گلوله‌ای می‌پردازیم. جهت بررسی بهتر خواص اشاره شده، ماده مورد نظر را با میزان آلایش‌های مختلف (۰/۷۵ و ۰/۲۵-۰) تهیه کردیم و برای این منظور از نیترات آهن ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$), نیترات منگنز ($(\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) استات کروم ($\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_3 \cdot (\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O})$) و اسید سیتریک (۰/۱) جهت ساخت نمونه‌ها استفاده کردیم.

سپس با استفاده از آزمایش‌های مختلف از جمله پراش پرتو X (XRD) میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی (FESEM) و مغناطش ارتعاشی (VSM) و پذیرفتاری سنج مغناطیسی متناوب به مطالعه‌ی ویژگی‌های مواد ساخته شده پرداختیم که به نتایج زیر رسیدیم:

نتیجه تحلیل XRD نشان داد که نمونه‌های ساخته شده ساختار فریت اسپینلی دارند و تشکیل فاز فریت منگنز به وسیله تحلیل قله‌های پراش تأیید شد. همچنین اندازه بلورک‌ها با استفاده از معادله شرر حدود ۴ تا ۴/۵ نانومتر بدست آمد. و دریافتیم که با افزایش میزان آلایش، اندازه بلورک‌ها کاهش پیدا می‌کنند. ولی تصاویر FESEM آگلومری (کلوخگی و بهم چسبیدن) ذرات ساخته شده را نشان داد که اندازه کلوخه‌ها حدود ۵۰ نانومتر و بیشتر تشخیص داده شد. اندازه‌گیری مغناطش نمونه‌ها نشان داد که با افزایش میزان آلایش کروم به جای آهن، مغناطش کاهش داشته است.

با بررسی پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونه‌ها به این نتیجه رسیدیم که مواد ساخته شده ابر شیشه اسپینی با برهمکنش زیاد هستند.

فهرست :

فصل اول

| | |
|---|-------------|
| ۲ | مقدمه |
|---|-------------|

فصل دوم

| | |
|-----|------------------------------------|
| ۱-۲ | مواد مغناطیسی |
| ۲-۲ | دو قطبی مغناطیسی |
| ۳-۲ | الای مغناطیسی (شار مغناطیسی) |
| ۴-۲ | گشتاور دو قطبی مغناطیسی |
| ۵-۲ | مغناطش |
| ۶-۲ | پذیرفتاری مغناطیسی |
| ۷-۲ | انواع مواد مغناطیسی |
| ۱ | دیا مغناطیس |
| ۲ | پارا مغناطیس |
| ۳ | فرومغناطیس |
| ۴ | پادفرومغناطیس |
| ۵ | فری مغناطیس |
| ۸-۲ | حوزه های مغناطیسی |

۹-۲) ناهمسانگردي مغناطيسی ۲۰

الف) ناهمسانگردي شکلی ۲۰

ب) ناهمسانگردي بلوري ۲۰

ج) ناهمسانگردي تنشی (كرنشی) ۲۰

د) ناهمسانگردي سطحي ۲۱

۱۰-۲) حلقه هيسترزيس ۲۱

۱۱-۲) برهmekنكشهاي مغناطيسی ۲۳

الف) برهmekنكش دوقطبی - دوقطبی ۲۳

ب) برهmekنكش تبادلی ۲۴

ج) برهmekنكش ابرتبادلی ۲۶

۱۲-۲) ابر پارا مغناطيسی ۲۸

۱۳-۲) شيشه اسپينی ۲۹

۱۴-۲) ابر شيشه اسپينی و ابر فرو مغناطيسی ۳۱

فصل سوم

۱-۳) روشهای ساخت نانو مواد ۳۵

۱- سل-ژل ۳۵

۲- رسوب دهی شيميايي بخار ۳۶

| | |
|----|--|
| ۳۷ | ۳- قوس پلاسما..... |
| ۳۷ | ۴- آسیاب گلوله ای..... |
| ۳۹ | ۲-۳) فریتهای مغناطیسی..... |
| ۴۱ | ۳-۳) دسته بندی فریتها..... |
| ۴۲ | ۴-۳) اسپینل های نرمال و معکوس..... |
| ۴۴ | ۵-۳) معرفی چند فریت اسپینلی..... |
| ۴۴ | الف) فریت آهن..... |
| ۴۵ | ب) فریت کبات..... |
| ۴۷ | ج) فریت منگنز..... |
| ۴۹ | ۶-۳) برخی روش‌های ساخت نانوذرات فریت منگنز..... |
| ۴۹ | ۱- روش سل-ژل به کمک مایکروویو..... |
| ۵۱ | ۲- روش گرمایی، در یک محلول آبدار (شامل نیترات‌های فلزی، pvp و آب دیونیزه)..... |
| ۵۶ | ۳- ساخت نانوذرات فریت منگنز به روش خود احتراقی..... |
| ۵۸ | ۷-۳) فریت منگنز آلایش داده شده با کادمیوم..... |
| | فصل چهارم |
| ۶۴ | ۱-۴) محاسبات مورد نیاز برای ساخت نانوذرات فریت منگنز($MnFe_{2-x}Cr_xO_4$) |
| ۶۷ | ۲-۴) مراحل ساخت نمونه ها..... |

۳-۴) دستگاه ها و تجهیزات مشخصه یاب این تحقیق..... ۶۹

الف) دستگاه های مشخصه یاب ساختاری

۱) دستگاه پراش پرتو ایکس..... ۶۹

۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) ۷۰

ب) دستگاه های مشخصه یاب مغناطیسی

۱) پذیرفتاری سنج متناوب..... ۷۱

۲) دستگاه مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) ۷۲

فصل پنجم

۱-۵) تحلیل پراش پرتو ایکس (XRD) نمونه ها..... ۷۴

۲-۵) بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) ۷۹

۳-۵) منحنی های پسماند مغناطیسی نمونه ها با آنالیز VSM ۸۱

۴-۵) پذیرفتاری مغناطیسی متناوب..... ۸۳

الف) مدل نیل-براون..... ۸۴

ب) مدل و گل-فالچر..... ۸۶

ج) مدل توان دینامیکی..... ۸۷

د) پارامتر Φ ۸۸

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰

منابع ۹۲

فصل ١

مقدمة

مقدمه

به طور کلی فریت (Ferrites) به آن دسته از مواد مغناطیسی گفته می شود که جزء اصلی تشکیل دهنده آنها، اکسید آهن است و پارامترهای مغناطیسی مطلوبی نظری ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی، مقاومت ویژه الکترونیکی بالا و ... از جمله اصلی ترین خصیصه های آنها به شمار می رود.

به سبب همین خصوصیات ویژه، این مواد کاربردهای بسیار زیادی در زمینه صنایع برق؛ الکترونیک، مخابرات کامپیوتر، پزشکی و ... دارند. تحقیقات علمی راجع به فریتها از اواسط قرن ۱۹ آغاز شد.

پس از آن تحقیقات توسط دو دانشمند ژاپنی به نام های T.Takeshi و k.yogoro در جهت کاربردهای صنعتی دنبال شد نتایج تحقیقات آنها بر روی فریت های مس و کبالت در سال ۱۹۳۲ ارائه گردید [۱ و ۲].

پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ شخصی به نام J.L snoek وجود ماده ای مغناطیسی از نوع سرامیک (فریت) را با خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی بسیار بالا، مقاومت الکترونیکی خوب و تلفات هدایتی کم جهت استفاده در رادارها کشف و در سال ۱۹۴۷ نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد [۱ و ۲]. در سال ۱۹۴۸ شخصی به نام L.Neel تئوری خود را بر مبنای فری مغناطیس ارائه داد. پس از آن تحقیقات مغناطیسی بر اساس فریت ها گسترش یافت و دانشمندان دیگر توانستند ترکیبات مختلفی از مخلوط اکسیدهای آهن، نیکل، منگنز و روی را مورد آزمایش قرار دهند و به نتایج بسیار مطلوبی از مقاومت بالا در مقایسه با فلزات دست یابند [۳].

از طرف دیگر رسوخ علم نانو (یا همان نانو تکنولوژی) در رشته ها و زمینه های گوناگون علمی به صورت روزافزون دانش مغناطیس را نیز بی بهره نگذاشت و هر روزه شاهد پیشرفت علم نانو ذرات مغناطیس می باشیم. پیشوند نانو به معنای یک میلیاردیم (10^{-9}) است.

علم نانو به بررسی مواد با این مقیاس می پردازد. مواد نانو ساختار به موادی گفته می شود که حداقل در یک بعد کمتر از 100nm باشند.

افزایش کابردهای نانوذرات (که به دلیل اثرات اندازه ریز آنها است) باعث شده تا دانشمندان و محققان بیش از پیش به این زمینه بها داده و با اشتیاق بیشتر به ساختار مطالعه نانو مواد بپردازنند.

برای ساخت مواد در ابعاد نانو دو روش کلی وجود دارد:

۱- روش بالا به پایین (یعنی خرد کردن، کوچک کردن و آسیاب کردن مواد بزرگ تر به

ابعاد کوچک تر

۲- روش پایین به بالا (تشکیل پیوند بین اتم ها و مولکول ها و رشد دادن آنها و کنار هم

قرار دادن آنها برای ساخت مواد بزرگتر)

از جمله روش های مرسوم تهیه نانو ساختارها (از روش بالا به پایین) می توان به:

• آسیاب کاری (balimilling)

• کند و پاشی

• لیتوگرافی و ...

اشاره کرد.

و برای روش های تهیه مواد نانو از روش پایین به بالا می توان به:

سل - ژل

هم رسوبی

تجزیه گرمایی و ...

اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد با ورود علم نانو به رشته مغناطیسی شاخه‌ای از فناوری نانو به نام نانومغناطیس شکل گرفت که به بررسی رفتار مغناطیسی مواد مختلف در ابعاد نانو می‌پردازد.

در این ابعاد مغناطیش مواد به شدت تحت تاثیر اندازه نمونه قرار می‌گیرد و ممکن است رفتاری کاملاً متفاوت با حالت حجمی نشان دهد در این حوزه اثرات سطحی وارد شده و ناهمسانگردی سطحی مطرح می‌شود که در ابعاد ماکروسکوپیک وجود ندارد. از جمله مواد مورد توجه این شاخه (نانومغناطیس) نانو ذرات فریت‌های اسپینلی می‌باشد که به دلیل کاربردهای فراوانی که ذکر شد مورد توجه ویژه هستند.

در این پایان نامه به ساخت و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری فریت اسپینلی منگنز خالص ($MnFe_{2-x}Cr_xO_4$) و آلاییده به کروم (به جای آهن) ($MnFe_{2-x}Cr_xO_4$) با ($x = 0/25, 0/5, 0/75$) می‌پردازیم. در فصل ۲ کلیاتی از مغناطیس و ویژگی‌های مغناطیسی مواد ذکر خواهد شد. در فصل ۳ به بررسی روش‌های ساخت نانو ذرات و آشنایی با فریتها و انواع آن می‌پردازیم.

در فصل ۴ مراحل ساخت و آزمایشات ماده مورد نظر در آزمایشگاه شرح داده خواهد شد. همچنین به معرفی دستگاه‌های مورد استفاده در این تحقیق خواهیم پرداخت.

در فصل ۵ نتایج آزمایشات و اندازه گیری‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

فصل ۲

مغناطیس

(آشنایی با انواع مواد مغناطیسی و ویژگیهای آنها)

۲-۱) مواد مغناطیسی

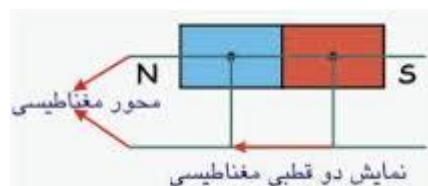
کلیه موادی که با اعمال میدان مغناطیسی، مغناطیس می شوند را مواد مغناطیسی می گویند که به دو دسته‌ی کلی مواد مغناطیسی فلزی و مواد مغناطیسی سرامیکی تقسیم می شوند.

از لحاظ الکتریکی، مواد مغناطیسی فلزی جزء هادیها و مواد مغناطیسی سرامیکی جزء نیمه هادی‌ها و عایق‌ها طبقه بندی می شوند [۴].

۲-۲) دو قطبی مغناطیسی

همانطور که در اطراف بارهای الکتریکی میدان الکتریکی ایجاد می شود، در اطراف قطب‌های مغناطیسی نیز میدان مغناطیسی به وجود می آید. اگر فرض شود نظیر بارهای الکتریکی، بارهای مغناطیسی هم وجود دارند، این بارها همیشه به صورت جفت‌هایی با بزرگی یکسان ولی علامت مخالف با فاصله‌ی کمی از یکدیگر قرار دارند که به آن دوقطبی مغناطیسی می گویند (q_m ، $-q_m$) (یا N ، S) (شکل ۱-۲).

همانطور که دو قطبی‌های الکتریکی از میدان‌های الکتریکی تاثیر می پذیرند دو قطبی‌های مغناطیسی نیز تحت تاثیر میدان‌های مغناطیسی قرار می گیرند. و در داخل میدان مغناطیسی نیروی گشتاوری را اعمال می کند که دو قطبی‌ها را وادار به جفت شدن با همدیگر می سازد.



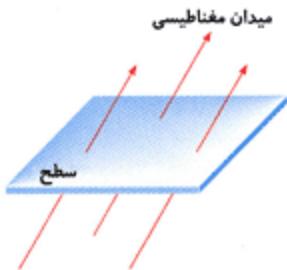
شکل ۱-۲ : دو قطبی مغناطیسی

۲-۳) القای مغناطیسی (شار مغناطیسی) B

القای مغناطیسی (B) تعداد خطوط القاء شده که یک سطح مشخص دارد در زاویه 90° درجه قطع می کند می باشد،(شکل ۲-۲) و واحد آن $\frac{wb}{m^2}$ (شار به سطح) است. در فضای آزاد برابر با $B = \mu \cdot \vec{H}$ و اگر فضا با یک ماده مغناطیسی پر شده باشد برابر است با:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \quad (1-2)$$

μ_0 نفوذ پذیری مغناطیسی در خلاء و \vec{H} میدان مغناطیسی است.



شکل ۲-۲: شار مغناطیسی عبوری از یک سطح

۲-۴) گشتاور دو قطبی مغناطیسی

گشتاور مغناطیسی یک آهنربا معیاری از تمایل آن نسبت به هم خط شدن با یک میدان مغناطیسی است.

گشتاور مغناطیسی معمولاً به گشتاور دو قطبی مغناطیسی سیستم، که نخستین جمله از بسط چند جمله ای یک میدان مغناطیسی عمومی است اشاره دارد. گشتاور دو قطبی مغناطیسی q_m, q_m - که در قسمت قبل شرح داده شده عبارت است از:

$$\vec{\mu}_m = -q_m \vec{d} \quad (2-2)$$

d برداری است که دو بار را به هم وصل می کند.

هنگامی که میدان خارجی باشد B بر این دو قطبی اعمال شود، گشتاور زیر بر دو قطبی اثر می کند:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu}_m \times \vec{B} \quad (3-2)$$

که بر اثر آن دو قطبی با میدان هم جهت می شود.

برای یک حلقه‌ی حامل جریان یا یک الکترون در حال چرخیدن نیز به صورت مشابه داریم:

$$\mu_m = I \vec{A} \quad (4-2)$$

(I جریان حلقه یا جریان ناشی از حرکت الکترون است و A مساحت حلقه است یا مساحت حلقه
ی مسیر حرکت الکترون)

که با کمک از روابط $A = \pi r^2$ و $I = e \left(\frac{\omega}{2\pi} \right)$ می رسمیم به :

ω سرعت زاویه‌ای است .

و مجدداً با کمک از اندازه حرکت زاویه‌ای الکترون ($L = m r^2 \omega$) داریم:

$$\mu_m = \left(\frac{-e}{2m} \right) L \quad (5-2)$$

که ضریب $\left(\frac{-e}{2m} \right)$ نسبت ژیرومغناطیسی نامیده می شود [۵] .

واحد گشتاور مغناطیسی مگنتون بوهر نام دارد ($\mu_B = \frac{e\hbar}{2n_e} 10^{-24}$) و مقدارش $9/27$ است . [۴۵]

۲-۵) مغناطش

گشتاور دو قطبی مغناطیسی واحد حجم ماده را مغناطش گویند. اگر فرض کنیم که ماده از اتم های با گشتاور مغناطیسی μ_i تشکیل شده باشد، (یعنی گشتاور دو قطبی i امین اتم ما μ_i باشد) در این صورت مغناطش به صورت حد نسبت مجموع تمام گشتاور دو قطبی های مغناطیسی بر حجم ΔV ، زمانی که ΔV به سمت صفر میل کند تعریف می شود.

به بیان ریاضی:

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \sum_i \mu_i \quad (6-2)$$

است $[9] \cdot \frac{A}{M}$. واحد مغناطش برابر با

۲-۶) پذیرفتاری مغناطیسی

به جوابی که ماده مغناطیسی در مقابل میدان خارجی می دهد پذیرفتاری مغناطیسی گویند. این پاسخ به شکل یک گشتاور مغناطیسی می باشد که متناسب با میدان اعمال شده است. با افزایش شدت میدان خارجی، این گشتاور القایی به یک مقدار حدی میل می کند. صرف نظر از این خاصیت اشباعی، رابطه این دو (گشتاور القایی و میدان مغناطیسی خارجی اعمالی) به صورت خطی است و نسبت بین آنها (که می توان ویژگی های مغناطیسی مواد را از آن مشخص کرد) پذیرفتاری مغناطیسی نام دارد [۱۰].

از آنجا که میدان مغناطیسی اعمالی می تواند ثابت یا متناوب باشد، لذا پذیرفتاری نیز بر دو نوع خواهد بود،

پذیرفتاری مغناطیسی dc:

پذیرفتاری مغناطیسی که با اعمال میدان مغناطیسی ثابت به دست می آید پذیرفتاری dc نامیده می شود.

$$x_{dc} = \frac{M}{H_{dc}} \quad (7-2)$$

پذیرفتاری مغناطیسی ac

پذیرفتاری مغناطیسی که با اعمال میدان مغناطیسی متناوب به دست می آید پذیرفتاری ac نامیده می شود.

$$x_{ac} = \frac{dM}{dH_{ac}} \quad (8-2)$$

حال اگر میدان مغناطیسی اعمالی ، میدان مغناطیسی متناوب و به صورت زیر باشد:

$$\vec{H}_{(t)} = \vec{H}_{ac} \cos(\omega t) \quad (9-2)$$

آنگاه مغناطش نیز وابسته به زمان به صورت زیر خواهد بود

$$\vec{M}_{(t)} = \vec{H}_{ac} \sum_{n=1}^{\infty} [x'_n \cos(\omega t) + x''_n \sin(\omega t)] \quad (10-2)$$

که $x_n = x'_n + i x''_n$.
[۱۱] n امین هارمونیک پذیرفتاری است (...و ۲ و ۱ و ۰) (n=۰)

پس مؤلفه های حقیقی و موهومی پذیرفتاری به صورت زیر به دست می آیند: